

〒240-8501 横浜市保土ヶ谷区常盤台 79-1

第30回半導体・オブ・ザ・イヤー2024 半導体製造装置部門「優秀賞」を受賞

「新たなチップ集積手法による Die-to-Wafer ハイブリッド接合技術の開発」

【研究概要】

横浜国立大学総合学術高等研究院、半導体・量子集積エレクトロニクス研究センターの副センター長である井上史大准教授は、株式会社ディスコ、東レエンジニアリング株式会社と共同で開発した、「新たなチップ集積手法による Die-to-Wafer ハイブリッド接合技術の開発」が、電子デバイス産業新聞（発行：株式会社産業タイムズ社）が主催する半導体・オブ・ザ・イヤー2024 半導体製造装置部門の「優秀賞」を受賞しました。

6月12日に電子回路業界で世界最大級の展示会「電子機器ソリューション展 2024 (JPCA Show 2024 など)」が開催中の東京ビッグサイト会場内にて授賞式とプレゼンテーションが行われました。

【研究成果】

「半導体・オブ・ザ・イヤー」は電子デバイス産業新聞が、最新のエレクトロニクス製品の開発において最も貢献した製品を称えるため毎年開催しており、本年度で記念すべき第30回を迎えます。製品・技術の新規性、半導体業界に与えたインパクト、将来性などを基準に、同新聞記者の投票によって受賞製品・技術が選定されます。

受賞技術は新たな仮接合技術により、歩留まり向上、高いボンディング位置合わせ精度、およびコスト削減を伴う高度な異種3D集積が可能となり、今後きたる「ヘテロロジーニアスデバイス」の時代の基盤となり得る、独創性と応用可能性の非常に高い技術である点が評価され「優秀賞」を受賞しました。

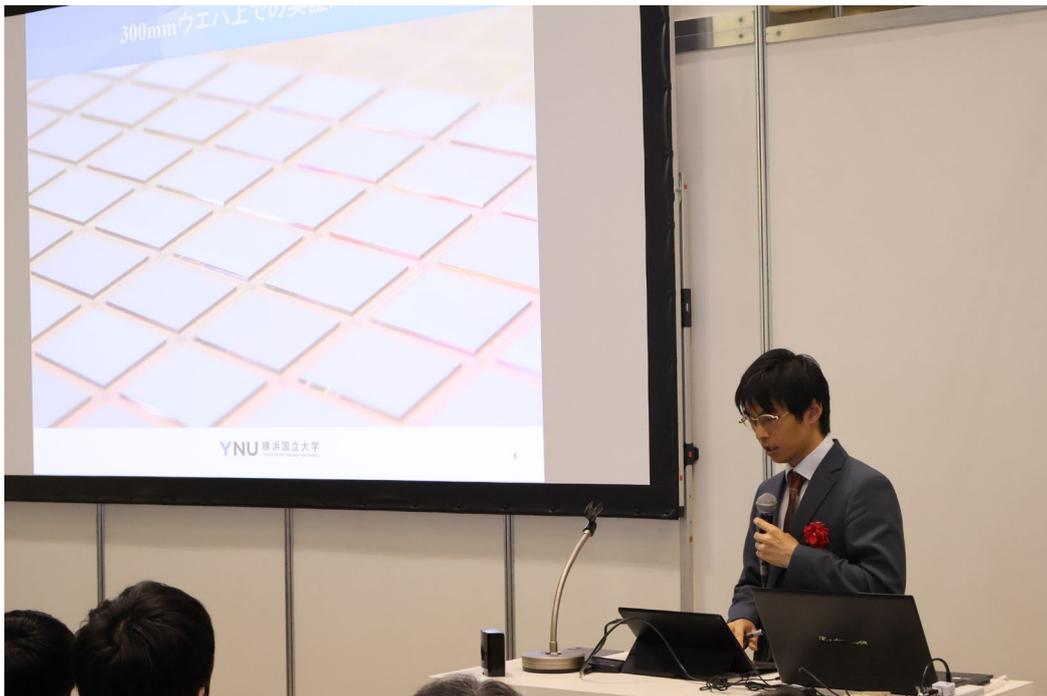
今後も半導体の低消費電力化、高性能化を目指して、装置と集積技術の開発を進め半導体業界のさらなる発展に貢献していきます。

*本成果は NEDO 官民による若手研究者発掘支援事業の支援により達成されました。

https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100166.html



授賞式の様子（中央が井上史大准教授）



授賞式でのプレゼンの様子

本件に関するお問い合わせ先

横浜国立大学 高等研究院 総合学術高等研究院

半導体・量子集積エレクトロニクス研究センター

副センター長 井上 史大 (inoue-fumihiro-ty@ynu.ac.jp; TEL 045-339-3861)